基于狄拉克半金属宽带的可调谐太赫兹偏振器

田元仕, 郭晓涵*, 戴林林, 张会云, 张玉萍

山东科技大学电子信息工程学院,青岛市太赫兹技术重点实验室,青岛 266590

摘要 提出了一种基于狄拉克半金属超材料的双开口环结构的宽带偏振器,研究了狄拉克半金属费米能级以及中 间介质厚度对偏振转换性能的影响。结果表明:当中间介质厚度为 22 μm,费米能级为 70 meV 时,在 1.44 THz 和 1.95 THz 两个谐振频率处,偏振转换效率为 100%;当中间介质厚度为 22 μm 时,随着狄拉克半金属费米能级从 64 meV增加到 70 meV,高低两个谐振峰均产生蓝移;当狄拉克半金属费米能级为 70 meV 时,随着基底介质厚度 从 19 μm 增加到 22 μm,低频处的谐振峰未移动,高频率点处的谐振峰红移。 关键词 太赫兹技术;超材料;偏振;狄拉克半金属

中图分类号 O436.3 **文献标识码** A

doi: 10.3788/CJL201946.0614033

Broadband Tunable Terahertz Polarizers Based on Dirac Semimetal

Tian Yuanshi, Guo Xiaohan*, Dai Linlin, Zhang Huiyun, Zhang Yuping

College of Electronic and Information Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao Key Laboratory of Terahertz Technology, Qingdao, Shandong 266590, China

Abstract In this study, we propose a broadband polarizer based on the "double-split ring" structure of a Dirac semimetal metamaterial. Further, we investigate the influences of the Dirac semimetal Fermi level and the intermediate dielectric thickness on the polarization conversion performance. The results show that the polarization conversion efficiency is 100% at two resonance frequencies of 1.44 THz and 1.95 THz for an intermediate dielectric thickness of 22 μ m and a Fermi level of 70 meV. In addition, For a 22 μ m thick intermediate dielectric, the two resonant peaks at high and low frequencies show a blue shift as the Dirac semimetal Fermi level increases from 64 meV to 70 meV. Moreover, for a Dirac semimetal Fermi level of 70 meV, as the substrate dielectric thickness increases from 19 μ m to 22 μ m, the resonant peak at low frequency does not shift, whereas that at high frequency exhibits a red shift.

Key words terahertz technology; metamaterial; polarization; Dirac semimetal OCIS codes 160.3918; 040.2235; 260.5430

1引言

与太赫兹辐射源、探测器一样,太赫兹功能器件 在推动太赫兹技术发展和应用中占有极其重要的地 位。其中,太赫兹偏振操控器件在太赫兹开关、偏振 转换、波前操控等领域具有重要应用,是太赫兹波操 控器件中不可或缺的组成部分,已成为目前研究的 热点。

传统的光学偏振操控器件主要采用旋光晶体、 法拉第非互易材料、光学各向异性介质、扭曲向列型 液晶等实现偏振操控^[1-2]。但此类偏振操控器件存 在一些缺陷,如需外加静磁场、光路准直困难、体积 较大不利于系统集成等,在很大程度上限制了其在 太赫兹领域的应用^[3]。太赫兹超表面可以有效弥补 上述缺陷,可以通过优化微结构参数实现对入射太 赫兹波振幅、相位、工作频率、偏振状态等的任意操 控。2013年,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的 Grady等^[4]率先开展了金属超表面反射式和透射式 偏振转换器的研究,线偏振(LP)转换效率超过 80%。Chiang等^[5]研究了S型和非对称开槽谐振 环组成的透射型宽带线偏振转换器,其平均转换效 率达到了 60%,工作频率范围为 0.71~1.05 THz。

收稿日期: 2019-01-29; 修回日期: 2019-03-04; 录用日期: 2019-04-03

基金项目:国家自然科学基金(61875106,61775123)、山东省研究生导师指导能力提升项目(SDYY17030)

^{*} E-mail: sdust_thz@163.com

Lévesque 等^[6]设计了一种宽角度入射的反射型偏振转换器件,太赫兹波以 45°角入射时,偏振转换效率仍然大于 80%。天津大学的 Cong 等^[7]采用双圆环链结构实现了线偏振和椭圆偏振的转换;2014 年和 2015 年该团队又实现了聚酰亚胺隔离的三层金属光栅完美偏振转换器件,该器件具有高效宽带的性能^[8-9]。2018 年,周璐等^[10]提出了一种基于 L 形微结构单元阵列的太赫兹波段宽带反射型偏振转换器,其在 0.64~1.19 THz 频率范围内,可以实现转换效率大于 80%的偏振转换,最大偏振转换效率达到 95%以上。2018 年,李永花等^[11]提出了一种基于各向异性超表面的太赫兹宽带偏振转换器,该偏振转换器可以在 0.4~1.04 THz 频率范围内将线偏振的太赫兹波偏振方向旋转 90°,转换效率达 90%以上。

以上研究工作主要集中在如何提高器件的转换 效率和工作带宽等方面,并取得了一定成果,但偏振 转换器件依据优化的仿真参数进行加工后,其功能 也就随之确定,工作频率和偏振转换特性不能改变。 要想改变器件的工作频率和偏振转换特性,必须对 超表面结构单元的参数及构成形式进行重新设计、 加工,从而在一定程度上限制了器件的应用。因此, 发展可调谐太赫兹波偏振操控器件具有广阔的应用 前景,并成为重要的发展方向。一般采用将超表面 与液晶、半导体、相变材料和非线性介质等光学活性 材料相结合的方法来解决这一问题[12-14]。这些超表 面的光学响应可以通过电场、磁场、电压或温度等外 部激励来主动控制,其中的电压控制在实际操作中 是最方便实用的方法之一。石墨烯是典型的活性材 料,可以支持表面等离激元,其光学响应取决于外部 偏压可控的费米能级[15-17]。最近,科研工作者将石 墨烯应用到可调谐太赫兹波偏振操控器件的设计 中,并取得了不错的研究成果[18-24]。

狄拉克半金属被称为三维石墨烯,因为它的体 电子形成了三维的狄拉克锥结构。与石墨烯相比, 狄拉克半金属不易受到介电环境的干扰,表面没有 过剩电子,更容易制备且性能稳定。狄拉克半金属 的介电功能可以通过改变其费米能级进行动态调 节,基于此,可以通过在金属线连接的狄拉克半金属 层的上下表面之间施加栅极电压^[25],或者通过碱性 表面掺杂改变狄拉克半金属的费米能量来调节其介 电功能^[26],使其实现从介质到半金属再到金属态的 切换。目前,对于狄拉克半金属费米能级与外加电 压之间对应关系的问题,还没有相关的研究成果。 所以,本课题组从理论上给定了狄拉克半金属费米 能级的大小,实现了偏振转换器优良的偏振转换性 能。可以预测,狄拉克半金属的费米能级电压调控 特性将在微结构超表面器件中具有一定的应用潜 力。将狄拉克半金属材料刻蚀成亚波长微结构或互 补微结构的超表面,可以实现器件工作频率等的调 谐^[27-31]。

基于以上研究背景,本文提出了一种基于狄拉 克半金属在太赫兹频段的宽带反射型偏振转换器, 该转换器由两个不对称的狄拉克开口圆环组成。研 究结果表明,通过提高结构中间介质的厚度或狄拉 克半金属的费米能级,均可以提高偏振器的偏振转 换效率,实现宽带偏振转换。此外,通过改变狄拉克 半金属的费米能级可以使偏振器在不同的频率范围 内实现宽带偏振转换。该器件可实现正交偏振转换 功能,当中间介质的厚度为 22 μm、狄拉克半金属的 费米能级为 70 meV 时,偏振器在 1.36~2.07 THz 频率范围内的偏振转换效率大于 80%,该偏振控制 器具有宽频段、可调谐的特点,是理想的太赫兹波段 偏振转换器。目前,基于狄拉克半金属超表面器件 的设计正处于理论研究阶段,尚未有实验器件的报 道,本文的设计也还未应用到实际的器件制作中。

2 理论模型及计算方法

本课题组设计的基于狄拉克半金属的双开口环 偏振转换器结构如图 1 所示,正交转换器由三层结 构组成,由前到后依次为双开口环狄拉克半金属结 构、介质隔离层、完美电导体(PEC)基底。在该结构 中设定参数如下:单元周期长度 $p = 92 \ \mu m, 双开口$ $圆环结构的内径 <math>W_1 = 12 \ \mu m, 外径 W_2 = 20 \ \mu m, 单$ $个开口环的开口角度 <math>\alpha = 45^\circ$,单个开口环的开口宽 度 $W_3 = 8 \ \mu m, 两个开口环的间距 W_4 = 25 \ \mu m 。材$ $料参数如下:狄拉克半金属结构的厚度为 0.1 \ \mu m,$ $介质隔离层的介电常数 <math>\epsilon = 2.06$,损耗角的正切值为



图 1 所提偏振器的 3×3 单元结构图 Fig. 1 Structural diagram of 3×3 unit in proposed polarizer

 $0.0004^{[32-33]}$,介质层的厚度 $h_1 = 22 \ \mu m$,PEC 基底的 厚度 $h_2 = 0.1 \ \mu m$ 。

根据随机相位近似理论(PRA),利用 Kubo 公式可得出狄拉克半金属的表面电导率:

$$\operatorname{Re}\sigma(\Omega) = \frac{e^2}{\hbar} \frac{gk_{\rm F}}{24\pi} \Omega G(\Omega/2), \qquad (1)$$

$$\operatorname{Im}\sigma(\Omega) = \frac{e^2}{\hbar} \frac{gk_{\rm F}}{24\pi^2} \left\{ \frac{4}{\Omega} \left[1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{T}{E_{\rm F}} \right)^2 \right] + 8\Omega \int_0^{\epsilon_{\rm c}} \left[\frac{G(\epsilon) - G(\Omega/2)}{\Omega^2 - 4\epsilon^2} \epsilon d\epsilon \right] \right\}, \qquad (2)$$

式中:e 为电子电量; \hbar 为约化普朗克常数;g 为简 并因子; $k_{\rm F} = E_{\rm F}/(\hbar v_{\rm F})$ 为费米动量,其中 $E_{\rm F}$ 为费 米能级, $v_{\rm F} = 10^6$ m·s⁻¹为费米速度; $\Omega = \hbar \omega/E_{\rm F}$, 其中 ω 为频率;T 为温度;G(E) = n(-E) - n(E), 其中E 为一个电子所占据的能量,n(E)为费米分 布函数; $\epsilon = E/E_{\rm F}$; $\epsilon_{\rm C} = E_{\rm C}/E_{\rm F}$,其中 $E_{\rm C}$ 为截止能 量,超过该能量,狄拉克谱不再是线性的。利用双带 模型,考虑带间电子跃迁,狄拉克半金属的介电常数 可表示为 $\epsilon = \epsilon_{\rm b} + i\sigma/(\omega\epsilon_0)$,其中: $\epsilon_{\rm b}$ 为有效背景介 电常数, $\epsilon_{\rm b} = 1$; ϵ_0 为真空中的介电常数; σ 为狄拉克 半金属的动态电导率。

偏振转换效率(PCR)可用来描述器件对线偏振 入射光的偏振转换能力,定义为

$$\begin{cases} P_{CR_x} = \frac{|r_{xy}|^2}{|r_{yy}|^2 + |r_{xy}|^2} \\ P_{CR_y} = \frac{|R_{yx}|^2}{|R_{yx}|^2 + |R_{xx}|^2}, \end{cases}$$
(3)

式中: r_{yy} 和 $r_{xy}(r_{ij}$ 表示来自j偏振入射的i偏振反 射率)为反射系数; R_{yx} 为x偏振入射的y偏振反射 率; R_{xx} 为x偏振入射的x偏振反射率, P_{CRx} 为y偏 振到x偏振的偏振转换效率; P_{CRy} 为x偏振到y偏 振的偏振转换效率。定义偏振度角 $\eta = \arctan(|E_{xx}|/|E_{yx}|)$,其中 E_{xx} 为x偏振反射波的 电场强度, E_{yx} 为y偏振反射波的电场强度。此外, 定义反射电磁波的y分量和x分量的相位差为 $\Delta \varphi_{xy} = \arg(r_{xy}) - \arg(r_{yy})$,其中 $\arg()$ 表示相位。 $\Delta \varphi_{xy}$ 的取值范围为[-180° , 180°]。

3 计算结果与分析

采用有限元法(FEM),利用 CST Microwave Studio 软件对该器件的偏振转换特性进行模拟计 算。模拟计算了当偏振方向平行于 y 轴的太赫兹 波沿 z 反方向垂直入射该器件时,反射光中 x、y 偏 振分量的反射率曲线,如图 2(a)所示。可以看出: 在 1.37~2.04 THz 的频率范围内,r_{xy}大于 0.9;在 1.44,1.95 THz 谐振频率点处,r_{xy}分别达到了 0.99 和 0.97,这表明入射的太赫兹波从沿 y 轴偏振到沿 x 轴偏振发生了约 90°的旋转。这里用偏振转换效 率来描述交叉偏振转换器的转换效率,如图 2(b)所 示,可以看出:在 1.36~2.07 THz 频率范围内,偏振 转换效率大于 0.8;在两个谐振频率点处,偏振转换 效率等于 1,这说明 y 偏振波在这两个频率点处完 全转换为x 偏振波。此外还计算得到了偏振方位



图 2 y 偏振入射波下线偏振转换的仿真结果。(a) r_{yy}和r_{xy};(b) PCR;(c)偏振方位角;(d) |r_{xy}|/|r_{yy}|和 Δφ_{xy}
Fig. 2 Simulated results of LP conversion pattern under y-polarized incident wave. (a) r_{yy} and r_{xy};
(b) PCR; (c) polarization azimuth angle; (d) |r_{xy}|/|r_{yy}| and Δφ_{xy}

角,结果如图 2(c)所示,可以看出,在 1.44, 1.95 THz谐振频率下的偏振度角分别为 90°,从而 进一步表明 y 偏振入射波在这两个谐振频率点处 完全转换为x 偏振波。另外,计算得到了正交偏振 反射率和共偏振反射率的绝对值之比和相位差,结 果如图 2(d)所示,可见:在 1.3 THz 处, $r_{xy} = r_{yy}$, $\Delta \varphi_{xy} = 89.3^{\circ}; 在 2.15 THz 处, <math>\Delta \varphi_{xy} = 93.5^{\circ},$ 这说明 在这两个频率点处实现了线-圆偏振转换。

研究了中间介质厚度 h 对偏振转换性能的影 响,结果如图 3 所示。从图 3(a)中可以看出,当中 间介质厚度从 19 μm 增加到 22 μm 时,两谐振峰之 间的同偏振反射系数的峰值从 0.65 减小到0.45,对 应图 3(b)中两谐振峰之间的正交偏振反射系数的 最小值从 0.75 增加到 0.88,这说明增加中间介质厚 度可以提高正交偏振反射系数的幅度。此外还计算 得到了偏振转换效率和相位差随中间介质厚度变化 的曲线,如图 3(c)和 3(b)所示,可见:随着中间介质 厚度增加,偏振转换效率增大,高频点处的谐振峰小 幅红移,这表明改变中间介质厚度可以对偏振器进 行调控。在图 3(c)中,随着介质厚度从 19 μ m 增加 到 22 μ m,低频点处的谐振峰未发生移动,高频点处 的谐振峰从1.98 THz红移到 1.95 THz,两谐振峰之 间的偏振转换效率从 0.57 提高到 0.8,对应图 3(d) 中相位差为 180°的频率点从 1.98 THz 红移到 1.95 THz。这说明通过改变中间介质厚度也可以 调控偏振转换效率和工作频率。



图 3 仿真得到的中间介质层厚度对线偏振转换性能的影响。(a)对 r_{yy} 的影响;(b)对 r_{xy} 的影响; (c)对 PCR 的影响;(d)对 $\Delta \varphi_{xy}$ 的影响

Fig. 3 Effect of intermediate dielectric thickness on LP conversion performance obtained by simulation. (a) Effect on r_{yy} ; (b) effect on r_{xy} ; (c) effect on PCR; (d) effect on $\Delta \varphi_{xy}$

为了进一步研究中间介质厚度对偏振器偏振转 换性能的影响规律,计算得到了如图 4(a)~(b)所 示的正交偏振反射系数和偏振转换效率。可以看 出:随着中间介质厚度在一定范围内继续增加,正交 偏振反射系数的幅度继续增加,并且当中间介质厚 度为 27 μ m 时,正交偏振反射系数在 1.43~ 1.95 THz频率范围内达到最大值,近似为 1,相应的 该频段内的偏振转换效率也达到最大值 1;随着中 间介质厚度从 27 μ m 增加到 42 μ m,正交偏振反射 系数的幅度一直在下降,相应的偏振转换率也同时 下降。在 42 μ m 厚度的基础上继续增加中间介质 内,该器件已经完全失去偏振器应有的偏振转换性 能。所以可以得到这样的结论:当狄拉克半金属费 米能级为70 meV时,27 μm的中间介质厚度是该偏 振转换器实现最优偏振转换性能的最佳厚度。

为了实现偏振转换的可调谐性,计算了偏振转 换效率和相位差随狄拉克半金属费米能级变化的曲 线,如图 5(a)~(b)所示,可见:随着狄拉克半金属 费米能级增加,偏振转换效率增大,两谐振峰以同等 幅度蓝移,证明了偏振转换的可调谐性。在图 5(a) 中,随着狄拉克半金属费米能级从64 meV增加到 70 meV,谐振频率分别从 1.36 THz 和 1.87 THz 蓝 移到1.44 THz 和 1.95 THz,两谐振峰之间的偏振





Fig. 4 Simulated results after increasing intermediate dielectric thickness. (a) r_{xy} ; (b) PCR



图 5 不断增加费米能级后的仿真结果。(a) PCR;(b) $\Delta \varphi_{xy}$ Fig. 5 Simulated results after continuously increasing Fermi level. (a) PCR; (b) $\Delta \varphi_{xy}$

转换效率从 0.67 提高到 0.8, 对应图 5(b)中相位差 为 0°的频率点从 1.36 THz 蓝移到 1.44 THz, 相位 差为 180°的频率点从 1.87 THz 蓝移到 1.95 THz。 这说明,可以通过改变狄拉克半金属的费米能级调 控偏振转换效率和工作频率。

为了与金属超表面偏振转换器的性能进行比较,分别计算了对应的金、铜超表面偏振转换器的 偏振转换效率,如图6所示,可以看出:两种金属 超表面偏振转换器的偏振转换效率曲线基本相同,但对应金属超表面偏振转换器没能实现宽带 偏振转换;与基于狄拉克半金属超表面偏振转换 器相比,对应金属超表面偏振转换器无法实现动 态调控。从而可以看出,与对应的金属超表面偏 振转换器相比,本课题组设计的基于狄拉克半金 属的超表面偏振转换器具有理想的宽带可调谐 特性。



图 6 对应金属超表面的偏振转换效率。(a)金超表面偏振转换器;(b)铜超表面偏振转换器 Fig. 6 Polarization conversion efficiency corresponding to metal meta-surface. (a) Gold meta-surface polarizer; (b) copper meta-surface polarizer

4 偏振转换的原理

图 7(a)中的插图为偏振转换的原理。对 y 偏

振波沿与y 轴呈 45°角的u 轴和v 轴方向进行分 解,因此入射波的电场强度可以表示为 $E_i = uE_{iu} \exp(j\phi) + vE_{iv} \exp(j\phi)$,反射波的电场强度可 表示为 $E_r = u \tilde{r}_u E_{ru} \exp(j\phi) + v \tilde{r}_v E_{rv} \exp(j\phi)$ 。其 中: ϕ 为相应的相位; $\tilde{r}_u \pi \tilde{r}_v$ 为沿u轴和v轴的反 射系数,结构的非对称性导致等效介电常数和等效 磁导率的各向异性,所以 $\tilde{r}_u \pi \tilde{r}_v$ 之间存在相位差。 当 $r_u = r_v, \Delta \phi \approx 180^\circ$ 时, $E_{ru} \pi E_{rv}$ 合成沿x轴方向



的电场强度 E_r 。图 7 给出了太赫兹波沿 u 轴和 v轴偏振时反射系数的幅值和相位,可见:在 1.36~ 2.07 THz频率范围内, $r_u \approx r_v$,且近似等于 1;在 1.36~2.07 THz范围内,反射系数的相位差约为 180°,实现了偏振转换。



图 7 电磁波沿 u 轴和 v 轴入射时的仿真结果。(a)反射系数幅值(插图为偏振转换原理图);(b)相位 Fig. 7 Simulated results of electromagnetic wave incident along u axis and v axis, respectively. (a) Amplitude of reflection coefficient (inset indicating principle diagram of polarization conversion); (b) phase

进一步利用偏振器表面和地板感应电流分布来 揭示偏振转换的物理机制,图 8 给出了1.44 THz和 1.95 THz 谐振频率下上层表面和地板上的表面电 流分布,可以看出:当谐振频率为 1.44 THz 时,上 层表面电流沿着两个开口的方向流动,此时,该结构 可视为电偶极子;当谐振频率为 1.95 THz 时,上层表 面电流可以看成是沿着两开口圆环之间的方向流动。 当上层表面电流分布与地板上的感应电流分布方向 相同时,就会产生电谐振,反之产生磁谐振。由图 8 (a)、(b)可知,在 1.44 THz 和 1.95 THz 处,表面电流 方向与 PEC 地板上的电流方向是相反的,说明两个 频率点处的谐振类型都是磁谐振。



图 8 不同谐振频率处狄拉克半金属和 PEC 地板上的表面电流分布。(a) 1.44 THz;(b) 1.95 THz Fig. 8 Surface current distributions on Dirac semimetal and PEC ground sheet at different resonant frequencies. (a) 1.44 THz; (b) 1.95 THz

5 结 论

基于狄拉克半金属电导率的可调谐特性,设计 了一种非对称双开口环结构的可调谐反射型线偏振 转换器。在1.36~2.07 THz频率范围内,该器件的 偏振转换效率大于 80%,在1.44~1.95 THz 频率 范围内实现了宽带偏振转换。研究了狄拉克半金属 费米能级与中间介质厚度对偏振器偏振性能的影 响,结果表明:通过改变狄拉克半金属的费米能级可 以使偏振器在不同的频率范围内实现宽带偏振转 换。最后分析了该偏振器的物理机制。该偏振器在 新型天线设计、隐身技术、通信和雷达探测等方面具 有一定的应用价值。

参考文献

- Saleh B E A, Teich M C. Fundamentals of photonics
 [M]. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.
- [2] Rutz F, Hasek T, Koch M, et al. Terahertz birefringence of liquid crystal polymers [J]. Applied Physics Letters, 2006, 89(22): 221911.
- [3] Chen S Q, Liu W W, Li Z C, et al. Polarization state manipulation of electromagnetic waves with metamaterials and its applications in nanophotonics
 [J]. Metamaterials: Devices and Applications, 2017: 217.
- [4] Grady N K, Heyes J E, Chowdhury D R, et al. Terahertz metamaterials for linear polarization

conversion and anomalous refraction [J]. Science, 2013, 340(6138): 1304-1307.

- [5] Chiang Y J, Yen T J. A composite-metamaterialbased terahertz-wave polarization rotator with an ultrathin thickness, an excellent conversion ratio, and enhanced transmission [J]. Applied Physics Letters, 2013, 102(1): 011129.
- [6] Lévesque Q, Makhsiyan M, Bouchon P, et al. Plasmonic planar antenna for wideband and efficient linear polarization conversion [J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(11): 111105.
- [7] Cong L Q, Cao W, Tian Z, et al. Manipulating polarization states of terahertz radiation using metamaterials[J]. New Journal of Physics, 2012, 14 (11): 115013.
- [8] Cong L Q, Xu N N, Gu J Q, et al. Highly flexible broadband terahertz metamaterial quarter-wave plate [J]. Laser & Photonics Reviews, 2014, 8(4): 626-632.
- [9] Cong L Q, Xu N N, Han J G, et al. A tunable dispersion-free terahertz metadevice with pancharatnam-berry-phase-enabled modulation and polarization control [J]. Advanced Materials, 2015, 27(42): 6630-6636.
- [10] Zhou L, Zhao G Z, Li Y H. Broadband terahertz polarization converter based on L-shaped metamaterial[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(4): 041602.
 周璐,赵国忠,李永花.基于L形超材料的太赫兹宽 费信振转输器[J]、激光与光电子受进展 2018 55

带偏振转换器[J].激光与光电子学进展,2018,55 (4):041602.

- [11] Li Y H, Zhou L, Zhao G Z. Terahertz broadband polarization converter based on anisotropic metasurface[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45 (3): 0314001.
 李永花,周璐,赵国忠.基于各向异性超表面的太赫 兹宽带偏振转换器[J].中国激光, 2018, 45(3): 0314001.
- [12] Khatua S, Chang W S, Swanglap P, et al. Active modulation of nanorod plasmons [J]. Nano Letters, 2011, 11(9): 3797-3802.
- [13] Shen N H, Massaouti M, Gokkavas M, et al. Optically implemented broadband blueshift switch in the terahertz regime [J]. Physical Review Letters, 2011, 106(3): 037403.
- [14] Zheludev N I, Plum E. Reconfigurable nanomechanical photonic metamaterials [J]. Nature Nanotechnology, 2016, 11(1): 16-22.
- [15] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al.
 Electric field effect in atomically thin carbon films
 [J]. Science, 2004, 306(5696):666-669.

- [16] Emani N K, Chung T F, Ni X J, et al. Electrically tunable damping of plasmonic resonances with graphene[J]. Nano Letters, 2012, 12(10): 5202-5206.
- [17] Valmorra F, Scalari G, Maissen C, et al. Low-bias active control of terahertz waves by coupling large-area CVD graphene to a terahertz metamaterial [J]. Nano Letters, 2013, 13(7): 3193-3198.
- [18] Cheng H, Chen S Q, Yu P, et al. Dynamically tunable broadband mid-infrared cross polarization converter based on graphene metamaterial [J]. Applied Physics Letters, 2013, 103(22):223102.
- [19] Cheng H, Chen S Q, Yu P, et al. Mid-infrared tunable optical polarization converter composed of asymmetric graphene nanocrosses [J]. Optics Letters, 2013, 38(9):1567-1569.
- [20] Li Y Z, Zhao J M, Lin H, et al. Tunable circular polarization selective surfaces for low-THz applications using patterned graphene [J]. Optics Express, 2015, 23(6): 7227-7236.
- [21] Yang C, Luo Y, Guo J X, et al. Wideband tunable mid-infrared cross polarization converter using rectangle-shape perforated graphene [J]. Optics Express, 2016, 24(15): 16913-16922.
- [22] Ding J, Arigong B, Ren H, et al. Mid-infrared tunable dual-frequency cross polarization converters using graphene-based L-shaped nanoslot array [J]. Plasmonics, 2015, 10(2): 351-356.
- [23] Guo T J, Argyropoulos C. Broadband polarizers based on graphene metasurfaces [J]. Optics Letters, 2016, 41(23): 5592-5595.
- [24] Gao X, Yang W L, Cao W P, et al. Bandwidth broadening of a graphene-based circular polarization converter by phase compensation [J]. Optics Express, 2017, 25(20): 23945-23954.
- [25] Liu Z K, Zhou B, Zhang Y, et al. Discovery of a three-dimensional topological Dirac semimetal, Na₃Bi
 [J]. Science, 2014, 343(6173): 864-867.
- Liu Z K, Jiang J, Zhou B, et al. A stable threedimensional topological Dirac semimetal Cd₃ As₂ [J]. Nature Materials, 2014, 13(7): 677-681.
- [27] Chen H, Zhang H Y, Liu M D, et al. Realization of tunable plasmon-induced transparency by brightbright mode coupling in Dirac semimetals[J]. Optical Materials Express, 2017, 7(9): 3397-3407.
- [28] Chen H, Zhang H Y, Guo X H, et al. Tunable plasmon-induced transparency in H-shaped Dirac semimetal metamaterial [J]. Applied Optics, 2018, 57(4): 752-756.
- [29] Dai L L, Zhang Y P, Guo X H, *et al*. Dynamically tunable broadband linear-to-circular polarization

converter based on Dirac semimetals [J]. Optical Materials Express, 2018, 8(10): 3238-3249.

- [30] Liu G D, Zhai X, Meng H Y, et al. Dirac semimetals based tunable narrowband absorber at terahertz frequencies [J]. Optics Express, 2018, 26 (9): 11471-11480.
- [31] Su Y, Lin Q, Zhai X, et al. Controlling terahertz surface plasmon polaritons in Dirac semimetal sheets
 [J]. Optical Materials Express, 2018 8(4): 884-892.
- [32] Rodrigo S G. Terahertz gas sensor based on absorption-induced transparency [J]. EPJ Applied Metamaterials, 2016, 3: 11.
- [33] Hejase J A, Paladhi P R, Chahal P P. Terahertz characterization of dielectric substrates for component design and nondestructive evaluation of packages [J].
 IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2011, 1 (11): 1685-1694.